

AXIAL LEADED HERMETICALLY SEALED SUPERFAST RECTIFIER DIODE

- Very low reverse recovery time
- Hermetically sealed in Metoxilite fused metal oxide
- Low switching losses
- Low forward voltage drop
- Soft, non-snap off, recovery characteristics

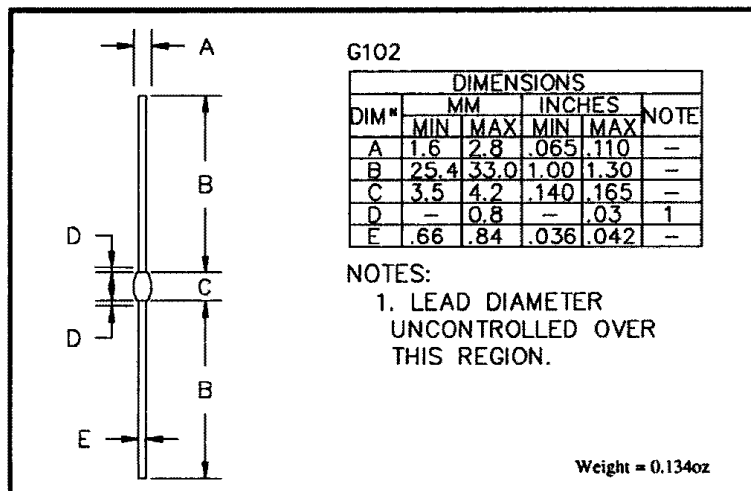
QUICK REFERENCE DATA

- $V_R = 50 - 150V$
- $I_F = 3.1A$
- $t_{rr} = 30ns$
- $V_F = 1.2V$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	1N6076 3FF05	1N6077 3FF10	1N6078 3FF15	Unit
Working reverse voltage	V_{RWM}	50	100	150	V
Repetitive reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	V
Average forward current (@ 55°C, lead length = 0.375")	$I_{F(AV)}$	← 3.1 →			A
Repetitive surge current (@ 55°C in free air, lead length 0.375")	I_{FRM}	← 14.0 →			A
Non-repetitive surge current ($t_p = 8.3ms$, @ V_R & T_{jmax})	I_{FSM}	← 70.0 →			A
Storage temperature range	T_{STG}	← -65 to +150 →			°C
Operating temperature range	T_{OP}	← -65 to +150 →			°C

MECHANICAL



These products are qualified to MIL-S-19500/503.

They can be supplied fully released as JAN, JANTX, and JANTXV versions.

January 7, 1998

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	1N6076 3FF05	1N6077 3FF10	1N6078 3FF15	Unit
Average forward current max. (pcb mounted; T _A = 55°C) for sine wave	I _{F(AV)}	← 1.30 →			A
for square wave (d = 0.5)	I _{F(AV)}	← 1.40 →			A
Average forward current max. T _L = 70°C; L = 0"	I _{F(AV)}	← 6.0 →			A
T _L = 55°C; L = 3/8"	I _{F(AV)}	← 3.0 →			A
for sine wave	I _{F(AV)}	← 3.1 →			A
for square wave	I _{F(AV)}	← 3.1 →			A
I ² t for fusing (t = 8.3mS) max.	I ² t	← 5.1 →			A ² S
Forward voltage drop max. @ I _F = 3.0A, T _j = 25°C	V _F	← 1.2 →			V
Reverse current max. @ V _{RWM} , T _j = 25°C	I _R	← 5.0 →			μA
@ V _{RWM} , T _j = 100°C	I _R	← 100 →			μA
Reverse recovery time 0.5A I _F to 1.0A I _R . Recovers to 0.25A I _{RR} .	t _{rr}	← 30 →			nS
Junction capacitance typ. @ V _R = 5V, f = 1MHz	C _j	← 60 →			pF

THERMAL CHARACTERISTICS

	Symbol	1N6076 3FF05	1N6077 3FF10	1N6078 3FF15	Unit
Thermal resistance - junction to lead Lead length = 0.0"	R _{θJL}	← 8.5 →			°C/W
Lead length = 0.375"	R _{θJL}	← 25 →			°C/W
Thermal resistance - junction to amb. on 0.06" thick pcb. 1 oz. copper.	R _{θJA}	← 90 →			°C/W

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9